

Количество мест

Количество бюджетных мест - **25**

Количество коммерческих мест - **10**

*Цена обучения в первом полугодии
70 300 рублей

В электронном виде заявление можно подать:

- Онлайн в личном кабинете поступающего УУНиТ на сайте: <https://uust.ru/admission/>
- Онлайн через портал Госуслуги
- В вузе: г.Уфа, ул. Карла Маркса д.12, к.6 и 7, 1 этаж

Вступительные испытания ЕГЭ

1. Математика (39/100)
2. Физика или химия (39/100) или информатика и ИКТ (44/100)
3. Русский язык (40/100)

* В скобках указаны минимальные проходные баллы из 100 возможных

” Контакты приемной КОМИССИИ

450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12,
корпуса 6 и 7, 1 этаж

Режим работы: пн-чт с 9:00 до 18:00
пт с 9:00 до 16:45
(перерыв с 13:00 до 13:45)

+7 (908) 350-49-84
+7 (917) 379-07-00

abiturient@uust.ru

Сайт приемной комиссии:
<https://uust.ru/admission/>



Контакты кафедры МиФМ

450008, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, корпус 8,
ауд. 305

+7 (908) 350-21-78

mifm@ugatu.su

Сайт кафедры МиФМ:
<https://uust.ru/mifm/>

Проезд до УУНиТ: остановки
общественного транспорта:
«Гостиный двор», «Дом актера»,
«УУНИТ» и «ЦУМ»



УФИМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Институт технологий и материалов (ИТМ)

22.03.01 **Материаловедение и технологии
материалов**

**профиль «Дизайн и цифровые технологии
перспективных материалов»**

Квалификация «БАКАЛАВР»
Обучение 4 года

» О направлении

Специалисты в области дизайна и цифровых технологий перспективных материалов являются проводниками новой технологической революции, поскольку именно они создают новые материалы для ведущих отраслей машиностроения, приборостроения, медицинской техники, определяющих научно-технический облик нашей промышленности.

Кафедра и лабораторная база

Выпускающая кафедра - «Материаловедение и физика металлов» - является одной из ведущих кафедр Уфимского университета науки и технологий. На кафедре МиФМ работают высококвалифицированные кадры: 13 докторов и 28 кандидатов наук. Ученые кафедры выполняют исследования мирового уровня в области новых наноструктурных материалов и покрытий.



Кто такие материаловеды?

Специалисты - материаловеды на производстве осуществляют входной контроль материалов, исследуют структуру и подтверждают их свойства, проводят неразрушающий контроль изделий. Без специалистов - материаловедов была бы невозможна разработка технологий изготовления изделий из металлических, керамических и композиционных материалов для авиакосмической и медицинской отрасли, нанесение функциональных покрытий, 3D-печать полимерами и металлами, получение сверхтвердых алмазных композитов, реверс-инжиниринг при импортозамещении.

Реальные проекты

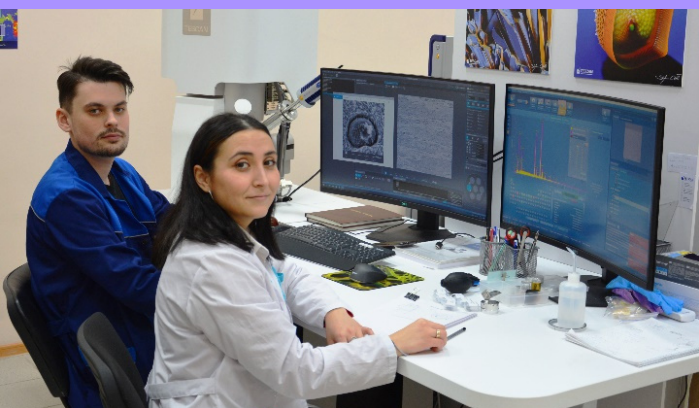
Студенты кафедры имеют возможность учиться и работать в лабораториях центра коллективного пользования «Нанотех» УУНиТ над реальными проектами в области:

- 3D печати полимерами и металлами
- электронной микроскопии
- механических испытаний
- рентгеноструктурного анализа
- неразрушающего контроля
- дефектоскопии изделий
- математического и физического моделирования материалов
- разработки керамических материалов

Трудоустройство

Выпускники по профилю «Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов» востребованы среди организаций, занимающихся производством высокотехнологичной продукции из передовых материалов.

- ПАО «ОДК УМПО»
- АО «Силловые машины»
- АО «ОДК НИИД»
- АО УАП «Гидравлика»
- ООО НПП «Буринтех»
- НПА «Технопарк авиационных технологий»
- ООО «Алком»
- ООО «Турбинаспецсервис»



Кафедра ведет совместную работу с ведущими зарубежными научно-исследовательскими центрами в области перспективных материалов и технологий. Так, в Китае это Нанкинский университет науки и технологий, Нанкинский технический университет, Университет Чанчжоу и другие. На кафедре ежегодно учится более 10 студентов из Китая.

Выпускники кафедры имеют возможность заниматься научной работой мирового уровня и трудоустроиваться в научно-исследовательские институты, такие как:

- Институт физики перспективных материалов УУНиТ
- Институт проблем сверхпластичности металлов РАН
- Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН